

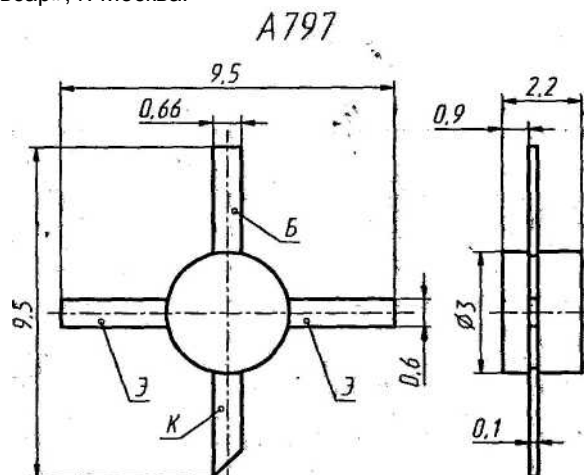
## A797

Транзистор кремниевый эпитаксиально-планарный структуры *p-p-p* генераторный. Предназначен для применения в усилителях мощности и генераторах в диапазоне частот до 2 ГГц в схеме с общим эмиттером в составе гибридных интегральных микросхем, блоков, обеспечивающих герметизацию и защиту транзисторов от воздействия влаги, соляного тумана, плесневых грибов, инея, росы, агрессивных газов и смесей. Бескорпусный на кристаллодержателе с гибкими выводами.

Тип прибора указывается в этикетке. На транзистор наносится красная точка.

Масса транзистора не более 0,2 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.



### Электрические параметры

Выходная мощность на $f = 2$ ГГц при $U_{КБ} = 7$ В, $I_K = 45$ мА, $\delta K_{y,p} = 2$ дБ, $T_K = +25$ °С, не менее .....	50 мВт
Коэффициент усиления по мощности на $f = 2$ ГГц при $U_{КБ} = 7$ В, $I_K = 45$ мА, $T_K = +25$ °С, не менее .....	8 дБ
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $C_{кэ} = 6$ В, $I_K = 30$ мА, не менее .....	20
Обратный ток коллектор-эмиттер при $U_{кэ} = 12$ В, $R_{БЭ} = 1$ кОм, не более .....	1 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭВ} = 2$ В, не более .....	0,1 мА

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} = 1$ кОм .....	12 В
Постоянное напряжение эмиттер-база .....	2 В
Потенциал статического электричества .....	100 В
Постоянный ток коллектора .....	60 А*
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора <sup>1</sup> при $T_K = -60...+60$ °С .....	375 мВт
Тепловое сопротивление переход-корпус .....	200 °С/Вт
Температура <i>p-p</i> перехода .....	+135 °С
Температура окружающей среды .....	-60... $T_K = +125$ °С

\* это не я, это в справочнике так! Видимо всё же мА...

<sup>1</sup> При  $T_K > +60$  °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле  $P_{K_{\text{макс}}} = (135 - T_K)/200$ , Вт

Минимальное расстояние места пайки выводов от кристаллодержателя 2 мм, температура пайки не выше +260 °С, время пайки не более 3 с. Припой ПОС-61. Допускается пайка (сварка) выводов на расстоянии не менее 0,5 мм от кристаллодержателя, при этом температура кристаллодержателя не должна превышать +150 °С. Перед пайкой выводы промывают спиртом, а затем смачивают флюсом. Состав флюса: 10...40% канифоли, 90...60% спирта.

При монтаже транзисторов в гибридной схеме рекомендуется приклеивать основание кристаллодержателя к теплоотводящей поверхности монтажной платы теплопроводящим клеем УП-5-207М ТУ 6-05-241-208-79. Перед нанесением клея кристаллодержатель транзистора и монтажная плата должны быть прогреты при  $+60 \pm 5$  °С в течение  $6 \pm 1$  мин. Не допускается наличие щелей и свищей. После приклеивания производится подсушка при  $+120 \pm 5$  °С в течение 1 ч и при +150 °С в течение 2 ч. Разрешается монтаж транзисторов в гибридной схеме производить припайкой металлизированного основания кристаллодержателя к теплоотводящей поверхности при температуре пайки не выше +180 °С.

Допускается обрезать выводы на расстоянии не менее 1 мм от кристаллодержателя.

При установке в гибридную схему транзистор должен плотно прилегать к теплоотводу. Шероховатость контактной поверхности теплоотвода должна быть не более 1,6 мкм, неплоскостность не более 0,02 мм.

Допускается применение транзистора на частотах более 2 ГГц, при этом нормы на электрические параметры не гарантируются.